

江苏南大光电材料股份有限公司

关于购买专利资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买美国杜邦集团（英文全称：DuPont de Nemours, Inc.）的全资子公司美国 DDP 特种电子材料公司（英文全称：DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC，以下简称“DDP 公司”）名下新型硅前驱体系列的 19 项专利资产组。购买价款包括一次性付款 1000 万美元和商业化付款，即转让专利有效期间所有涵盖产品净销售额的 8.5%。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为进一步完善产业链，丰富前驱体产品结构，增强技术实力，提高公司在行业中的地位和竞争优势，公司于 2020 年 9 月 4 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于购买专利资产的议案》，同意公司购买 DDP 公司名下新型硅前驱体系列的 19 项专利资产组。购买价款包括一次性付款 1000 万美元和商业化付款，即转让专利有效期间所有涵盖产品净销售额的 8.5%。资金来源为公司自有或自筹资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。近日，公司与 DDP 公司协商拟定了《资产购销协议》。董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理本次购买专利资产事项涉及的相关事宜。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：美国 DDP 特种电子材料公司（英文全称：DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC）

地 址：美国特拉华州威尔明顿市中心路 974 号，邮编 19805

公司类型：有限责任公司

注册 号：6406159

注册日期：2017 年 5 月 10 日

最终控股方：DuPont de Nemours, Inc.（美国杜邦集团）

主要业务： DDP 公司系美国杜邦集团的全资子公司，主要从事美国杜邦集团旗下的电子材料的技术研发，知识产权管理，生产和销售。

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的专利的基本情况

公司本次拟购买的 19 项专利资产组，涵盖近 10 个新型硅前驱体的化学成分、合成/生产工艺和应用，在全球主要芯片制造国家和地区适用。这些高性能硅前驱体可通过化学气相沉积或原子层沉积生成新型半导体所需要的特种含硅薄膜，可以满足高性能计算和低功耗需求的高级逻辑和存储器芯片制造要求，应用领域主要有电脑、手机芯片等。标的专利资产清单如下表（不包括 6 项正在受理尚未公开的专利申请）：

序号	专利类别	专利名称	国际申请号	国家或地区	国家或地区专利号	法律状态
1	发明专利	Composition Comprising Neopentasilane and Method of Preparing Same	PCT/US2007/019165	美国	US12/440299	授权
		含新戊硅烷的组合物及其制备方法		中国	CN200780039179.X	授权
		네오펀타실란을 포함하는 조성물 및 이의 제조 방법		韩国	KR1020097008553	授权
		ネオペンタシランを含む組成物及びその製造方法		日本	JP2009534570	授权
		Composition comprising neopentasilane and method of preparing same		欧洲	EP2007811642	授权
		包含新戊矽烷之組合物及其製造方法		台湾	TW096134053	授权
		Composition comprising neopentasilane and method of preparing same		新加坡	SG200901906	授权

2	发明专利	Method of making 2,2,4,4-tetrasilylpentasilane	PCT/US2014 /053774	美国	US14/915404	授权
		2, 2, 4, 4-四甲硅烷基五硅烷及其组合物、方法和用途		中国	CN201480054107.2	授权
		발명의 명칭 2,2,4,4-테트라실릴펜타실란 및 이의 조성물, 방법 및 용도		韩国	KR1020167008588	实质审查
		2,2,4,4-テトラシリルペンタシラン並びにその組成物、方法及び使用		日本	JP2016540322	授权
		2,2,4,4- tetrasilylpentasilane and its compositions, methods and uses		欧洲	EP2014766329	授权
		2,2,4,4-四矽基五矽烷及其組成物、方法及用途		台湾	TW103130048	授权
3	发明专利	Monoaminosilane Compounds	PCT/US2015 /033074	美国	US15/314323	授权
		单氨基硅烷化合物		中国	CN201580023434.6	实质审查
		모노아미노실란 화합물		韩国	KR1020167036446	授权
		單胺基矽烷化合物		台湾	TW104117615	公开
4	发明专利	Diaminosilane Compounds	PCT/US2015 /033075	美国	US15/314300	授权
		二氨基硅烷化合物		中国	CN201580027866.4	实质审查
		다이아미노실란 화합물		韩国	KR1020167036880	授权
		ジアミノシラン化合物		日本	JP2017515018	授权
		ジアミノシラン化合物		日本	JP2019126265	实质审查
		二胺基矽烷化合物		台湾	TW104117616	公开
5	发明专利	Process of synthesizing diisopropylamino-disilanes	PCT/US2015 /033092	美国	US15/300987	授权
		다이아이소프로필아미노-다이실란의 합성 공정		韩国	KR1020167036883	授权
		다이아이소프로필아미노-다이실란의 합성 공정		韩国	KR1020197000853	实质审查
		合成二異丙基胺基-二矽烷之程序		台湾	TW104117612	实质审查
6	发明专利	Silicon Precursor, Method of Forming A Layer Using The Same, and Method of Fabricating Semiconductor Device Using The Same	N/A	美国	US15/223685	授权
		발명의 명칭 실리콘 전구체, 이를 이용한 박막 형성 방법 및 이를 이용한 반도체 장치의 제조 방법		韩国	KR1020150053180	实质审查
7	发明专利	Pentachlorodisilane	PCT/US2016 /033263	美国	US15/558726	授权
		五氯二硅烷		中国	CN201680028698.5	实质审查
		펜타클로로실란		韩国	KR1020177035370	实质审查
		ペンタクロロジシラン		日本	JP2017559637	授权
		Pentachlorosilane		欧洲	EP2016726733	实质审查

		五氯二砷烷		台湾	TW105115713	实质审查
8	发明专利	Method for Fabricating Semiconductor Device Including Forming A Dielectric Layer on A Structure Having A Height Difference Using ALD	N/A	美国	US15/414913	授权
		制作半导体装置的方法及形成介电层的方法		中国	CN201810069059.4	实质审查
		반도체 장치의 제조 방법		韩国	KR1020170017908	公开
		半導体装置の製造方法		日本	JP2018009515	公开
9	发明专利	Tris(disilanyl)amine	PCT/US2016 /067075	美国	US15/776851	实质审查
		三(乙硅烷基)胺		中国	CN201680070868.6	实质审查
		트리스(다이실라닐)아민		韩国	KR1020187018305	公开
		トリス(ジシラニル)アミン		日本	JP2018528601	实质审查
		Tris(disilanyl)amine		欧洲	EP2016822354	授权
		參(二砷烷基)胺		台湾	TW105141901	实质审查
10	发明专利	二硅烷基胺和聚硅烷基胺的合成	PCT/US2016 /067127	中国	CN201680072355.9	实质审查
		다이실라닐아민 및 폴리실라닐아민의 합성		韩国	KR1020187018306	实质审查
		ジシラニルアミン及びポリシラニルアミンの合成		日本	JP2018530829	实质审查
		合成二砷烷基胺與聚砷烷基胺		台湾	TW105141894	实质审查
11	发明专利	High purity trisilylamine, methods of making, and use	PCT/US2016 /067143	美国	US16/061477	实质审查
		高纯度三甲硅烷基胺、制备方法和用途		中国	CN201680080583.0	实质审查
		고순도 트라이실릴아민, 제조 방법, 및 용도		韩国	KR1020187019383	实质审查
		高純度トリシリルアミン、その製造方法、及び使用		日本	JP2018531566	实质审查
		High purity trisilylamine, methods of making, and use		欧洲	EP2016840347	实质审查
		高純度三砷胺、製造方法、及用途		台湾	TW105141895	实质审查
12	发明专利	Method for Making An Organoaminosilane; A Method for Making A Silylamine from the Organoaminosilane	PCT/US2016 /067152	美国	US16/061461	实质审查
		制备有机氨基硅烷的方法；由有机氨基硅烷制备甲硅烷基胺的方法		中国	CN201680080575.6	实质审查
		오가노아미노실란의 제조 방법 및 오가노아미노실란으로부터 실릴아민을 제조하는 방법		韩国	KR1020187019018	实质审查
		オルガノアミノシランの製造方法、そのオルガノアミノシランからのシリルアミンの製造方法		日本	JP2018531616	实质审查
		Method for making an organoaminosilane; a method for making a silylamine from the		欧洲	EP2016840348	实质审查

		organoaminosilane				
		製造有機胺基矽烷之方法；自該有機胺基矽烷製造矽烷胺之方法		台湾	TW105141899	实质审查
13	发明专利	Aminochlorohydridodisilanes	PCT/US2017/032619	美国	US16/300201	实质审查
		氨基氯氢二硅烷		中国	CN201780028078.6	实质审查
		아미노클로로하이드리도다이실란		韩国	KR1020187034969	实质审查
		アミノクロロヒドリドジシラン		日本	JP2018556485	授权
		胺基氯氢二矽烷		台湾	TW106116176	实质审查
14	发明专利	Trichlorodisilane	PCT/US2017/052609	美国	US16/327872	实质审查
		三氯二硅烷		中国	CN201780057569.3	实质审查
		트라이클로로다이실란		韩国	KR1020197009956	实质审查
		トリクロロジシラン		日本	JP2019515826	实质审查
		Trichlorodisilane		欧洲	EP2017778100	公开
		三氯二矽烷		台湾	TW106133001	公开
15	发明专利	Catalysis of Dehydrocoupling Reactions between Amines and Silanes	PCT/US2017/063590	美国	US16/340431	授权
		胺与硅烷之间的脱氢偶联反应的催化		中国	CN201780079489.8	实质审查
		아민과 실란 간의 탈수소커플링 반응의 촉매 작용		韩国	KR1020197020360	实质审查
		アミンとシランとの間の脱水素カップリング反応の触媒作用		日本	JP2019534333	公开
		Catalysis of dehydrocoupling reactions between amines and silanes		欧洲	EP2017811813	实质审查
		胺與矽烷之間之脫氫耦合反應催化		台湾	TW106144433	公开
16	发明专利	Method of Making Aluminum-Free Neopentasilane	N/A	美国	US16/004802	实质审查
		Method of making aluminum-free neopentasilane		欧洲	EP2018179116	授权
17	发明专利	1,1,1-三氯乙硅烷的合成	PCT/US2018/038711	中国	CN201880051020.8	实质审查
		1,1,1-트리클로로디실란의 합성		韩国	KR1020207001674	公开
		1,1,1-トリクロロジシランの合成		日本	JP2019570832	公开
		1,1,1-三氯二矽烷之合成		台湾	TW107122060	公开
18	发明专利	制备五氯二硅烷的方法和包含其的纯化反应产物	PCT/US2018/044390	中国	CN201880058352.9	实质审查
		펜타클로로디실란 및 이를 포함하는 정제 반응 생성물의 제조 방법		韩国	KR1020207005320	公开
		Method of preparing pentachlorodisilane and purified reaction product comprising same		欧洲	EP2018755366	公开
		製備五氯二矽烷之方法及包含五氯二矽烷之經純化的反應產物		台湾	TW107123211	公开
19	发明	1,1,1-三(有机氨基)二硅烷化合物及其	PCT/US2018	中国	CN201880059969.2	实质审查

专利	制备方法	/044392			
	1,1,1-트리스(오가노아미노)디실란 화합물 및 이의 제조 방법		韩国	KR1020207005146	公开
	1,1,1-tris(organoamino)disilane compounds and method of preparing same		欧洲	EP2018756047	公开
	1,1,1-參(二甲胺基)二矽烷及其製備方法		台湾	TW107123212	公开

DDP 公司保证对标的专利资产拥有有效的所有权，不存在任何质押或任何其他权利限制的情形，亦不存在侵犯或可能侵犯任何第三方知识产权的情形。

四、交易协议的主要内容及定价情况

卖方：美国 DDP 特种电子材料公司（英文全称：DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC）

买方：江苏南大光电材料股份有限公司

1、购买价款

购买价款包括一次性付款和商业化付款。

以卖方将知识产权资产出售和转让给买方为约因，买方在交割完成时应承担协议项下的义务，并向卖方支付购买知识产权资产的一次付款壹仟万美元以及卖方在本协议项下以及在所有附属协议项下提供的其他承诺、义务和对价，以及等同于商业化付款的额外对价，即等于转让专利有效期间所有涵盖产品净销售额的 8.5%。

2、支付期限

一次性付款期限：买方应在交割日以可立即用的美元资金通过电汇支付至卖方在交割日之前书面指定给买方的银行账户上。

商业化付款期限：买方应在期限内每个日历半年期结束后三十（30）天内支付所有欠卖方的商业化付款。所有商业化付款单位应为美元，通过电汇汇至卖方的银行账户向卖方付款，银行账户信息应由卖方提供给买方。如果买方任何商业化付款款项到期未支付，则应产生未付款利息，每年复利一次，年利率比付款到期日“The Bloomberg Financial News and Information System”公布的优惠利率高三（3）个百分点，直至付款。

3、定价情况

买卖双方以市场原则为定价基准，经双方充分协商确定。

4、销售、使用、转让及类似税收和费用

在卖方根据本协议向买方出售或转让知识产权资产时，所有适用的销售和使用、增值、转让和其他基于交易的税费，如税收、关税和政府征收的附加费（下称“交易税”），以及因买方的作为或不作为而应支付的所有利息和罚款均由买方承担。如果适用法律要求卖方向买方收取交易税并将交易税汇给有关税务机关，卖方将在卖方发票上分别向买方分项列示交易税。如果买方被免除交易税，买方应在交割日期之前向卖方提供相关的豁免文件。为了澄清起见，买方将有责任支付任何适用法律下的交易税，无论卖方是否收取和扣缴该交易税。

除上述交易税外，各方应自行承担各自的所得税或基于总收入或总进款的税收。

5、知识产权资产的所有权

卖方对知识产权资产拥有有效的所有权，且知识产权资产不存在任何留置权。与知识产权资产相关的税收没有拖欠或存在任何重大争议。

6、交割

本协议拟进行的交易交割（下称“交割”）应在特拉华州威尔明顿的卖方办公室进行，或通过电子文件交换文件进行，双方可在特拉华州时间上午 10:00 共同商定，具体日期和时间由双方商定；或双方书面约定的其他日期或时间（交割完成的时间和日期在下文中称为“交割日期”）。

交割时，买方应按照本协议所附的格式签署并交付附属协议，并按照协议规定进行一次付款。卖方应按照本协议所附的格式签署并交付附属协议，以便将知识产权的所有权转让给买方。在适用的情况下，买卖双方应向对方交付协议中所要求的文件。

交割前，卖方应向买方的外部法律顾问提供各发明人签署的转让协议副本，将转让专利的所有权利、所有权和利益转让给其各自的雇主（即转让专利的申请人）。

卖方和买方同意，在交割日期之后：在交割后 90 天内，卖方应根据协议规定的预期交付时间表，将转让技术档案交付给买方。

7、转让限制

买方具有使用知识产权资产的必要操作能力，且未经卖方事先书面同意，不得直接或间接将知识产权资产（或其任何用途）转让给任何第三方，除非按照本协议

的规定。

五、本次交易的目的及对公司的影响

1、合法性

本次公司购买标的专利符合国家相关法律、法规的要求并严格按照相关规定予以操作。

2、必要性

标的专利涵盖的新型硅前驱体产品，是美国杜邦集团根据全球主要的芯片制造企业的需求研发，具有前瞻性，其中 6 项技术属于全球首创技术，与公司的战略研发方向是一致的。为了相关产品产业化的顺利实施，公司本次购买标的专利的同时，聘请了原 DDP 公司的核心技术人员，也是标的专利中 18 项专利的共同发明人为公司员工。通过技术引进和人才引进相结合，加快公司前驱体业务的技术转型，为公司在前驱体领域的深度发展奠定基础。相关产品产业化成功后，将丰富公司产品结构，为公司业绩提供新的增长点，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

公司购买新型硅前驱体系列的专利资产组，有利于综合运用法律手段、行政手段加以保护，有利于合理规划和建设知识产权保护体系，持续保持市场的独占性。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为，本次公司购买标的专利符合国家相关法律、法规的要求并严格按照相关规定予以操作。公司通过技术引进和人才引进相结合，将加快前驱体业务板块的技术转型，丰富产品结构，进而提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力。该项交易是双方在协商一致的基础上达成的，交易价格的确定遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，符合公司发展战略，能够促进公司主营业务持续、稳定、健康发展。因此我们一致同意公司本次购买专利资产事项。

七、风险提示

1、截至本公告日，公司与 DDP 公司协商拟定的《资产购销协议》尚未正式签署，专利权人亦未变更，在变更专利权人时可能会存在一定的风险。公司将与交易对方积极配合，共同高效完成专利技术转让手续。

2、本次购买的 19 项专利资产尚未形成稳定量产的产品，且部分专利仍在实质审查阶段，后续是否能取得授权，相关产品能否产业化成功，为公司带来经济效益仍存在不确定性。公司聘请了原 DDP 公司的核心技术人员，也是标的专利中 18 项专利的共同发明人为公司员工，负责相关专利申请的后续审查及产品研发工作，并将持续进行技术储备，推动公司在硅前驱体板块的发展。

八、备查文件

- 1、《江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》；
- 3、《江苏南大光电材料股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议》；
- 4、《资产购销协议》。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日